



所内邮箱

用户名:

密码:

所长信箱 | 留言信箱



现在位置: 首页 > 新闻中心 > 学术交流

新闻中心

- 重要新闻
- 图片新闻
- 科研动态
- 学术交流
- 综合新闻
- 视频新闻

日本东北大学Dirk Ehrentraut教授访问理化所

发表日期: 2010-08-17

打印 字体大小: 大 中 小



Dirk教授作报告

应中国科学院功能晶体与激光技术重点实验室邀请,日本东北大学(Tohoku University) Dirk Ehrentraut教授于2010年8月16日访问理化所,并作了题为*Solvothermal Crystal Growth Technology for Bulk ZnO and GaN*的学术报告,与相关领域的科研人员和研究生进行了探讨与交流。

Dirk教授回顾了近几十年来生长GaN晶体的主要方法,包括氢化物气相外延法,高温高压法,助溶剂法以及氨热法;重点介绍了近年来新发展的氨热法生长GaN晶体的研究进展,讨论了不同矿化剂种类、浓度等对晶体生长的影响;同时介绍了采用液相外延法生长ZnO晶体的研究进展以及最新的研究结果。

Dirk Ehrentraut教授的主要研究方向为纳米-块状氮化物晶体和氧化锌晶体的制备以及材料表征等。



学术报告会会场

» 评论



版权所有：中国科学院理化技术研究所 Copyright © 2002-2008
地址：中国·北京 京ICP备05002791号